

2nd Atomic Layer Process (ALP) Workshop

日時：2016年7月15日（金） 午後1時-6時

場所：東京大学工学部4号館3階42号教室（419号室）（本郷キャンパス）

東京都文京区本郷7-3-1 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_05_j.html

参加ご希望の方は、事前のご登録をよろしくお願いたします。

事前登録連絡先： 浜口智志 (hamaguch@ppl.eng.osaka-u.ac.jp)

会議主旨：Atomic Layer Etching および Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition 技術の基礎を理解し、ガス・材料・プラズマ等の幅広い分野の研究者・技術者が同技術の問題意識を共有することにより、この分野の更なる技術革新を推進することを目的とする。

プログラム概要

13:00-13:10 浜口智志（阪大）： 開会のご挨拶：趣旨説明
1 13:10-13:50 町田英明（気相成長）： Atomic Layer Etching 推進に向けたボラタイルプリカーサーからの示唆
2 13:50-14:30 鈴木克昌（大陽日酸）： th-ALDにおけるSiN成長メカニズムに関する考察
3 14:30 - 15:10 野沢俊久（日本ASM）： PE-ALDにおけるSiO ₂ 成長メカニズム
break 15:10-15:30
4 15:30 - 16:10 Peng Shen（エア・リキード・ラボラトリーズ）：Precursor Characterizations & Delivery for ALD
5 16:10-16:30 唐橋一浩（大阪大学）： 原子層エッチングプロセスの現状と課題
6 16:30 - 16:50 木下啓藏（PETRA）： MRAMデバイスにおけるエッチング技術課題
7 16:50 - 17:30 堀岡啓治（AMAT）： プロセスの選択性について
17:30 - 17:50 総合討論
17:50 - 18:00 浜口智志（阪大）： 閉会のご挨拶
18:00 - 20:00 懇親会： 工学部2号館 レストラン「松本楼」